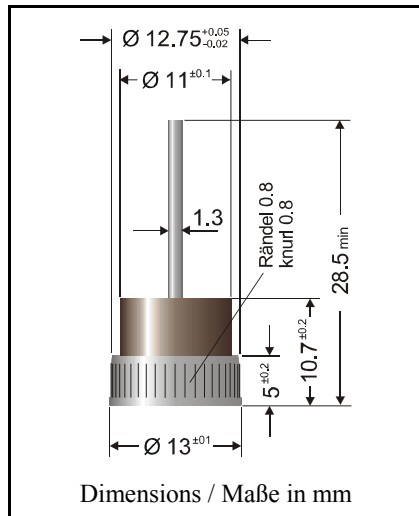


Silicon Press-Fit-Diodes
High-temperature diodes

Silizium-Einpreßdioden
Hochtemperaturdioden



Nominal current – Nennstrom 25 A

Repetitive peak reverse voltage 50...600 V
Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with plastic cover
Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ		Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Wire to / Draht an		Periodische Spitzensperrspanng.	Stoßspitzensperrspannung
Anode	Cathode	V _{RRM} [V]	V _{RSM} [V]
BYP 25A05	BYP 25K05	50	60
BYP 25A1	BYP 25K1	100	120
BYP 25A2	BYP 25K2	200	240
BYP 25A3	BYP 25K3	300	360
BYP 25A4	BYP 25K4	400	480
BYP 25A6	BYP 25K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	90 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270 / 300 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+215 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	– 50...+215 °C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 1\text{ K/W}$

